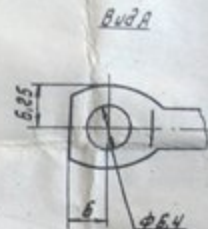
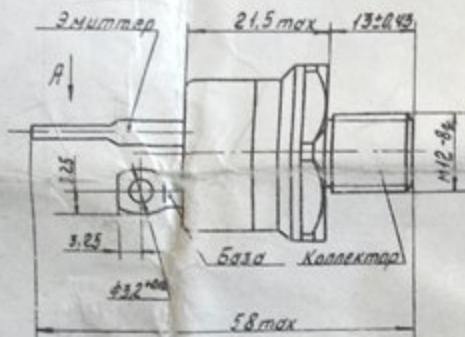




# ПАСПОРТ

ТРАНЗИСТОР СИЛОВОЙ КРЕМНИЕВЫЙ П-Р-П ТИПА ТН-152 - 80 100  
 СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ТУ16.729.311-81



Масса транзистора не более 56 г.  
 В одном транзисторе содержится 0,000061875 г.  
 золота и 0,002916 г. серебра.

1. Транзисторы по максимально допустимому напряжению коллектор-база делятся на классы

Класс	Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база, В		Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер, при токе базы равному		Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер, при заданном значении сопротивления в цепи база-эмиттер 3,4 Ом		Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер, при заданном обратном напряжении эмиттер-база 3 В.	
	U <sub>кб</sub>	В	U <sub>кэ0</sub>	В	U <sub>кэм</sub>	В	U <sub>кэх</sub>	В
ТН-152-80	5		30		45		45	
	10		40		90		90	
	15		60		135		135	
	20		90		180		180	
	25		120		225		225	
	30		150		270		270	
	40		180		315		315	
	50		240		360		360	
	60		300		450		450	
	80		360		540		540	
	100		450					
	120		540					

2. Транзисторы по напряжению насыщения коллектор-эмиттер делятся на группы

#### 4. Предельно допустимые эксплуатационные параметры

Наименование параметра	обозначение	Класс	Допустимое значение параметра
1. Максимально допустимый постоянный ток коллектора, при $T_K = 85^\circ\text{C}$ , $I_C = 0,2 I_{K_{max}}$	A	$I_{K_{max}}$	все классы 50 63
2. Максимально допустимый постоянный ток базы, при $T_K = 85^\circ\text{C}$	A	$I_{B_{max}}$	все классы 16 20
3. Максимально допустимый импульсный ток базы, при $T_K = 85^\circ\text{C}$ ,	A	$I_{B_{имп}}$	все классы 20 25
4. Максимально допустимое напряжение эмиттер-база	B	$U_{эб_{max}}$	0,5-2,0 2,5-6,0 4 6
5. Максимально допустимая температура перехода, $^\circ\text{C}$		$T_{max}$	все классы 150

#### 5. Условия хранения транзистора

Интервал температур  $-50^\circ\text{C} + 50^\circ\text{C}$   
Относительная влажность воздуха 90% при  $27^\circ\text{C}$ .

#### 6. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода транзистора в эксплуатацию.  
Срок сохранности - 3 года.

#### 7. Указания и рекомендации по эксплуатации

Монтаж транзистора должен обеспечивать надежный электрический и тепловой контакт между токоотводящими выводами и выводами аппаратуры, а также тепловой контакт между основанием транзистора и охладителем. Запрещается кручение выводов вокруг оси. При включении транзистора в схему, находящуюся под напряжением, базовый вывод присоединяется первым и отключается последним.

В процессе работы транзистора запрещается превышать предельно допустимые значения токов, напряжения и мощности, использовать транзистор в каких-либо экстремальных режимах.

При работе транзистора рекомендуется принимать меры; обеспечивающие минимальную температуру корпуса.

2. Транзисторы по напряжению усиления коллектор-эмиттер делятся на группы

Обозначение группы	Класс	Напряжение усиления коллектор-эмиттер, $\beta$ , не более
1	0,5- 2,0	0,6
2	0,5- 6,0	1,5
3	2,5- 6,0	-

3. Основные параметры

Наименование параметра и режим измерения	Обозначение	Класс	Норма, не менее	Норма, не более
1. Максимально допустимый импульсный ток коллектора при температуре корпуса $85^{\circ}\text{C}$ , $t_{\text{имп}}=100$ мс., скважности 2, А	$I_{\text{КВmax}}$	Все классы		60 100
2. Статический коэффициент передачи тока, при $I_{\text{К}}=0,5 I_{\text{КВmax}}$ , $U_{\text{КЭ}}=5\text{В}$ в схеме с общим эмиттером	$h_{21э}$	0,5-2,0 2,0-6,0	10 8	100 100
3. Напряжение усиления коллектор-эмиттер, при $I_{\text{К}}=0,5 I_{\text{КВmax}}$ , $I_{\text{Б}}=0,08 I_{\text{КВmax}}$	$U_{\text{КЭmax}}$	0,5-6,0		2
4. Время включения, при $I_{\text{К}}=0,5 I_{\text{КВmax}}$ , $I_{\text{Б}}=0,08 I_{\text{КВmax}}$ , $U_{\text{КЭ}} \leq U_{\text{КЭ0}}$ , мкс	$t_{\text{вкл}}$	0,5-2,0 2,5-6,0		0,35 1,0
5. Время выключения, при $I_{\text{К}}=0,5 I_{\text{КВmax}}$ , $I_{\text{Б}}=0,08 I_{\text{КВmax}}$ , $U_{\text{КЭ}} \leq U_{\text{КЭ0}}$ , мкс	$t_{\text{выкл}}$	0,5-2,0 2,5-6,0		2,0 4,0
6. Обратный ток коллектор-база, при $U_{\text{КБ}}=U_{\text{КЭ0}}$	мА	$I_{\text{КБ0}}$	0,5-6,0	10
7. Обратный ток эмиттера, при $U_{\text{ЭБ}}=4$ В,	мА	$I_{\text{Э0}}$	0,5-6,0	200
8. Тепловое сопротивление переход-корпус	$^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	$R_{\text{T,к}}$	0,5-6,0	0,35